

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2008-7610(P2008-7610A)

【公開日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2008-002

【出願番号】特願2006-178824(P2006-178824)

【国際特許分類】

C 08 J 7/04 (2006.01)

C 08 L 83/04 (2006.01)

C 08 K 5/00 (2006.01)

B 05 D 3/06 (2006.01)

B 05 D 7/24 (2006.01)

【F I】

C 08 J 7/04 C F H Z

C 08 L 83/04

C 08 K 5/00

B 05 D 3/06 1 0 2 Z

B 05 D 7/24 3 0 2 Y

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月9日(2009.1.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(I)

R_nSiX_{4-n}... (I)

(式中、Rは、式中のSiに炭素原子が直接結合するような有機基を表し、Xは、水酸基又は加水分解性基を表す。nは1又は2を表し、nが2のとき、Rは同一であっても異なっていてもよく、(4-n)が2以上のとき、Xは同一であっても異なっていてもよい。)で表される有機ケイ素化合物の縮合物を主成分とし、金属キレート化合物、金属有機酸塩化合物、2以上の水酸基若しくは加水分解性基を有する金属化合物、それらの加水分解物、及びそれらの縮合物からなる群より選ばれる少なくとも1種の350nm以下の波長の光に感応する光感応性化合物、及び/又はそれから誘導される化合物を含有するポリシリコキサン系複合体表面に、光触媒層を備えたことを特徴とする有機無機複合体。

【請求項2】

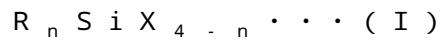
式(I)

R_nSiX_{4-n}... (I)

(式中、Rは、式中のSiに炭素原子が直接結合するような有機基を表し、Xは、水酸基又は加水分解性基を表す。nは1又は2を表し、nが2のとき、Rは同一であっても異なっていてもよく、(4-n)が2以上のとき、Xは同一であっても異なっていてもよい。)で表される有機ケイ素化合物の縮合物を主成分とし、層表面から深さ方向10nmにおける層表面部の炭素含有量が、層裏面から深さ方向10nmにおける層裏面部の炭素含有量の80%以下であるポリシリコキサン系層上に、光触媒層を備えたことを特徴とするポリシリコキサン系薄膜。

【請求項 3】

式 (I)



(式中、 R は、式中の Si に炭素原子が直接結合するような有機基を表し、 X は、水酸基又は加水分解性基を表す。 n は 1 又は 2 を表し、 n が 2 のとき、 R は同一であっても異なっていてもよく、 (4 - n) が 2 以上のとき、 X は同一であっても異なっていてもよい。) で表される有機ケイ素化合物及び / 又はその縮合物と、金属キレート化合物、金属有機酸塩化合物、 2 以上の水酸基若しくは加水分解性基を有する金属化合物、それらの加水分解物、及びそれらの縮合物からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の光感応性化合物とを含有するポリシロキサン系複合体形成用組成物を乾燥し、ポリシロキサン系複合体を形成するポリシロキサン系複合体形成工程と、

前記ポリシロキサン系複合体表面に、光触媒を含有する光触媒層形成用組成物を塗布し乾燥して光触媒層を形成する光触媒層形成工程と、

前記ポリシロキサン系複合体に対して、 350 nm 以下の波長の光を照射する UV 光照射工程とを有することを特徴とする有機無機複合体の製造方法。